

2SC182

NPN エピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ / NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor

低周波出力増幅用 / Low Frequency Amplifier
マイクロディスク / MICRODISK

特 徴

- ラジオ、テレビなどのドライバ、出力段用として最適です。
- 外形が小さいので機器の小形化が可能です。
- 自動生産ラインの採用により特性が均一です。
- エピタキシャル技術の採用によりコレクタ飽和電圧が低い。
- 低周波から高周波まで広範囲に使用できます。

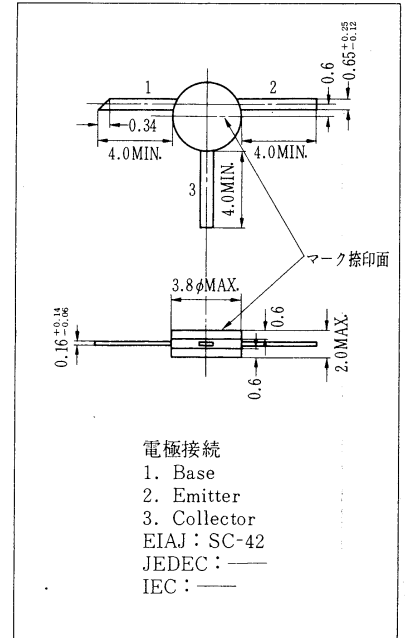
絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	25	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	15	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	150	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-30~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=20\text{mA}$	50	80	200	
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$		0.63		V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$		0.25	0.60	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}$	30	90		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=6.0\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		6.5	10	pF
ベース広がり抵抗	r_{bb}'	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}, f=200\text{MHz}$		25		Ω

外形図 (単位: mm)



特性曲線 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

